01,05

Электрическое сопротивление редкоземельных металлов и их сплавов при высоких температурах: роль магнитного рассеяния

© А.Д. Ивлиев

Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург, Россия E-mail: ad i48@mail.ru

Поступила в Редакцию 16 мая 2020 г. В окончательной редакции 22 мая 2020 г. Принята к публикации 26 мая 2020 г.

> Проанализированы результаты экспериментального исследования удельного электрического сопротивления редкоземельных металлов и их сплавов. Предложена процедура разделения вкладов в сопротивление. Установлено, что магнитный компонент электросопротивления в парамагнитной фазе снижается до нуля при нагреве. Отмечено, что современные модели явлений переноса не описывают данное явление.

> Ключевые слова: редкоземельные металлы, сплавы, удельное электрическое сопротивление, магнитный компонент сопротивления.

DOI: 10.21883/FTT.2020.10.49900.110

1. Введение

Редкоземельные металлы (P3M) — конденсированные фазы скандия, иттрия и лантаноидов [1]. Химические свойства P3M близки, что обусловлено однотипностью энергетических структур коллективизированных электронов. Тем не менее, обычно всю группу P3M разделяют на две подгруппы: иттриевую и цериевую. Металлы в пределах каждой из подгрупп проявляют наиболее близкие свойства. В данной статье будут рассмотрены металлы иттриевой подгруппы (то есть иттрий и тяжелые P3M от гадолиния по лютеций, исключая иттербий).

Сведения об удельном электрическом сопротивлении, представленные в настоящей статье, получены четырехзондовым методом на постоянном токе. Принцип работы типичной соответствующей экспериментальной установки описан, например, в [2].

В диапазоне высоких температур (то есть в парамагнитных областях выше температур Дебая) политермы электрического сопротивления чистых РЗМ [3] и их сплавов [4] однотипны. Скорость нарастания электрического сопротивления по мере нагрева снижается, а абсолютное значение удельного сопротивления оказывается достаточно высоким, превосходящим типичные значения этого параметра для прочих переходных металлов [3]. Важной особенностью политерм удельного электросопротивления является то, что они не образуют группу равноотстоящих друг от друга зависимостей, а представляют собой системы пересекающихся кривых. Данная особенность характерна как для чистых РЗМ, так и для исследованных сплавов.

Представляет интерес выяснение вопроса о том, какие механизмы рассеяния могут играть заметную роль в высокотемпературном электросопротивлении РЗМ и их сплавов? Энергетические структуры коллективизиро-

ванных электронов в рассматриваемых металлах, как уже отмечалось, однотипны [5-10]. Поэтому различия в значениях удельных электросопротивлений связаны, в основном, с параметрами ионов [11-13]. Массы ионов при движении по ряду РЗМ от иттрия до лютеция монотонно увеличиваются вдвое. Этот факт должен привести к тому, что удельное электрическое сопротивление РЗМ, обусловленное рассеянием электронов на колебаниях решетки, должно постепенно снижаться при движении от легких металлов к тяжелым [11-13]. Для самых высоких температур, вблизи температур плавления, это так [3,14,15]. В области средних температур, однако, рекордсменом является гадолиний, обладающий наибольшим удельным электрическим сопротивлением среди РЗМ [3]. Следовательно, кроме фононного, значительная роль в рассеянии электронов в рассматриваемой области температур принадлежит иному механизму, магнитному [11].

Магнитные свойства ионов P3M значительно различаются. Они определяются 4f-электронами, состояния которых в конденсированной фазе обладают атомными свойствами, и не образуют энергетические зоны [16,17]. У паулевских парамагнетиков (иттрий и лютеций) магнитные моменты ионов равны нулю. У каждого из прочих ионов P3M имеется магнитный момент, связанный со спиновым и орбитальным вкладами.

Наибольшие орбитальное и полное квантовые числа у иона гольмия [16,17]. Поэтому, казалось бы, именно гольмий должен обладать наибольшим вкладом магнитного рассеяния в электросопротивление. Однако это не так. Кроме того, температура перехода гольмия в парамагнитное состояние оказывается в два раза ниже, чем у гадолиния, для которого эта температура максимальная среди РЗМ [3]. Ион гадолиния не обладает орбитальным магнитным моментом, но обладает наибольшим спиновым моментом [16,17]. Таким образом, именно спиновый магнетизм ионов обеспечивает высокое электросопротивление металлического гадолиния и наибольшую температуру перехода в парамагнитное состояние. Данный результат находится в согласии с моделью косвенного обмена, при котором магнитное взаимодействие ионов РЗМ обусловлено именно спином ионов [6,7,16,17].

Кроме рассмотренных выше фононного и магнитного вкладов, в РЗМ и их сплавах присутствует еще и примесное рассеяние электронов. Других значимых механизмов рассеяния в рассматриваемом диапазоне температур нет [11–13]. В соответствии с правилом Маттиссена [11] полное удельное электросопротивление ρ можно представить в виде

$$\rho = \rho_L + \rho_M + \rho_r, \tag{1}$$

где ρ_L, ρ_M, ρ_r соответственно фононный, магнитный и примесный компоненты. Для выяснения причин наблюдаемого поведения ρ РЗМ и сплавов, необходимо оценить доли этих компонентов в полном сопротивлении. Иными словами, необходимо осуществить разделение вкладов в ρ .

2. Методы разделения вкладов в удельное электрическое сопротивление

Процедура разделения влияет на результат, и следовательно, от данной процедуры зависят физические выводы. Существуют три схемы разделения вкладов в ρ , используемые в настоящее время.

Первая схема основана на предположении, что фононное электрическое сопротивление любых металлов, в том числе и переходных, описывается законом Блоха [11]. В соответствии с ним ρ_L при высоких температурах пропорционально температуре Θ. Таким образом, прямая линия, проведенная от начала координат и параллельная высокотемпературному участку политермы $\rho(\Theta)$, отождествлялась с высокотемпературным вкладом фононов. Примесный компонент ρ_r считался не зависящим от температуры, поэтому его значение определялось на основании знания отношения удельных электросопротивлений образца при комнатной температуре и при гелиевой температуре (4.2 К), поскольку при гелиевых температурах остальные вклады в ρ , кроме примесного, становятся ничтожно малы [11]. Затем по формуле (1) вычислялось ρ_M .

Рассматриваемая схема использовалась очень широко для переходных, металлов (см., например, [3,6,16,18]). Результаты, получаемые таким методом очевидны. В РЗМ величина ρ_M оказывается значительно больше, чем ρ_L . Причем, учитывая, что политермы $\rho(\Theta)$ не прямые, а имеют отрицательную кривизну, ρ_L зависит от того, для какой области температур на зависимости $\rho(\Theta)$ определялся "прямолинейный" участок. Чем

при больших температурах он определен, тем меньшее значение имеет $\rho_L(\Theta)$. Вклад, рассматриваемый как магнитный, обнаруживается во всех РЗМ. В частности, в немагнитном иттрии он в несколько раз больше, чем фононное сопротивление и связывается с неким электрон-электронным рассеянием [3]. При этом в РЗМ величины ρ_M остаются значительными вплоть до температур плавления.

Существуют теоретические модели, позволяющие судить о температурной зависимости ρ_M в парамагнитной фазе, в области высоких температур. Большая их часть указывает на то, что ρ_M стремится к константе (т. е., имеет не нулевое значение) [6,16,19–21], или неограниченно возрастает пропорционально температуре [22]. Учитывая то, что как рассматриваемая методика разделения вкладов, так и модели магнитного рассеяния не обладают абсолютной точностью, между полученными экспериментальными результатами разделения вкладов и результатами теоретического рассмотрения противоречия нет. Это, однако, единственный положительный результат данного подхода.

Рассматриваемому методу разделения вкладов присущ недостаток, который является принципиальным — это использование модели Блоха для описания фононного сопротивления переходных металлов. Модель Блоха основана на использовании однополосной модели электронной проводимости, и в стандартном виде [11] не может быть использована для описания свойств переходных металлов, обладающих сложной электронной структурой [11,12]. Строго говоря, однополосная модель предназначена для щелочных металлов и не учитывает специфические процессы переноса заряда в многополосных системах [23]. Именно поэтому при обработке результатов возникают большие по величине вклады в сопротивление, которые, в рамках однополосной модели и рассматриваемой схемы разделения, приписываются магнитному рассеянию. Данные вклады появляются не только в иттрии, но во всех РЗМ — паулевских парамагнетиках. Такие выводы противоречит имеющимся фундаментальным результатам теории явлений переноса в твердых телах [11–13].

Результаты анализа электросопротивления, проведенные по первой схеме, не позволяют понять и ряд других особенностей политерм ρ P3M и сплавов, которые будут рассмотрены ниже, при описании процесса обработки экспериментальных данных (раздел 3). Иными словами, рассматриваемую первую схему разделения вкладов в удельное электросопротивление P3M (да и вообще, переходных металлов) следует признать ошибочной. Ошибочны, следовательно, и полученные с ее помощью выводы.

Вторая схема, в соответствии с которой можно разделить вклады в ρ , основана на том, что электросопротивление РЗМ — паулевских парамагнетиков, содержит только примесный и фононный компоненты. В частности, для рассматриваемых РЗМ, паулевскими парамагнетиками являются иттрий и лютеций. Следовательно, вычитая из ρ магнитных РЗМ ρ иттрия или лютеция, можно выделить магнитный вклад в сопротивление [24,25]. Физически данный подход представляется правильным. Выделенная таким образом магнитная составляющая удельного электросопротивления оказывается убывающей при возрастании температуры [24]. Недостатком рассматриваемого подхода является то, что ρ иттрия при высоких температурах оказывается больше, чем у других РЗМ, и разность удельных сопротивлений становится отрицательной (то есть стремится к отрицательной константе при повышении температуры). В случае, когда вычитается ρ лютеция, эта разность стремится к положительной константе. Иными словами, данный метод разделения вкладов, несмотря на физическую прозрачность, оказывается неоднозначным.

Третья схема разделения вкладов по физической сущности и по своим основным результатам оказывается близка ко второй схеме, однако в данном случае используется перенормировка удельных сопротивлений РЗМ, благодаря чему неоднозначность исключается. Следует отметить, что вторая и третья схемы разделения вкладов применимы только к материалам, имеющим подобные энергетические структуры внешних электронных состояний атомов, и следовательно, коллективизированных электронов в конденсированной фазе. Такими веществами среди элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева оказываются только РЗМ.

Суть метода разделения вкладов в электросопротивление чистых РЗМ изложена, например, в [26]. В основе ее лежит модель двухполосной проводимости Мотта [27] простейшая модель, предназначенная для описания кинетических явлений в переходных металлах. Отметим, что реально, энергетическая структура коллективизированных электронов в РЗМ более сложная, чем в используемой модели, однако такой упрощенный подход позволяет проследить за основными рассматриваемыми проблемами в аналитической форме, что удобно. Итак, модель рассматривает две энергетические полосы sи *d*-электронов. Первая *s*-полоса имеет сравнительно низкую и слабо изменяющуюся в зависимости от энергии W плотность электронных состояний $N_s(W)$. Вследствие этого, *s*-электроны обладают малой эффективной массой [13]. Вторая *d*-полоса является узкой, плотность состояний электронов в ней $N_d(W)$ выше, чем в *s*-полосе, и изменяется она в зависимости от энергии электронов значительно более сильно, чем $N_s(W)$. Вследствие этого, *d*-электроны имеют бо́льшую эффективную массу, чем *s*-электроны.

Наличие двух энергетических полос электронов позволяет полную проводимость вещества $\sigma = 1/\rho$ представить в виде суммы проводимостей каждой из полос

$$\sigma = 1/\rho = \sigma_s + \sigma_d, \tag{2}$$

где σ_s и σ_d — проводимости, обусловленные движением *s*- и *d*-электронов соответственно. Не претендуя на

$$\sigma = 1/\rho \approx \sigma_s = 1/\rho_s,\tag{3}$$

где ρ_s — удельное электрическое сопротивление проводника, создающееся за счет *s*-электронов. Величина удельного электрического сопротивления, а, следовательно, и проводимости, ограничивается процессами рассеяния носителей [13]. Вне зависимости от физической природы рассеяния, изменение состояния *s*-электрона может происходить двумя путями: либо электрон остается в *s*-полосе (*ss*-переход, вклад ρ_{ss}), либо переходит в *d*-полосу (*sd*-переход, вклад ρ_{sd}). Следовательно,

$$\rho \approx \rho_s = \rho_{ss} + \rho_{sd}. \tag{4}$$

Вероятности переходов определяются, в частности, плотностями электронных состояний вблизи химического потенциала η (то есть, при $W = \eta$) [13]. По оценке Займана [11]

$$\rho_{sd} \approx \rho_{ss} N_d(\eta) / N_s(\eta). \tag{5}$$

Таким образом [25],

$$\rho \approx \rho_{ss} + \rho_{sd} \approx \rho_{ss} + \rho_{ss} N_d(\eta) / N_s(\eta)$$
$$= \rho_{ss} [1 + N_d(\eta) / N_s(\eta)], \tag{6}$$

где ρ_{ss} — величина удельного электрического сопротивления, рассчитанная для одной *s*-полосы. Если выражение (6) используется для описания фононной составляющей ρ_L , то в качестве ρ_{ss} следует взять, например, формулу Блоха [12]:

$$\rho_{ss}(\theta) = \frac{(3\pi^2)^{1/3}\pi^3\hbar^3}{4e^2k} \frac{N^{1/3}}{n_a^{2/3}\theta_R^2 m_A V^{1/3}} \,\theta,\tag{7}$$

где n_a — число электронов проводимости на атом, m_A — масса иона, N — число ионов в объеме V, θ_R — кинетическая температура Дебая для электросопротивления, k — постоянная Больцмана, e — заряд электрона, Θ — температура.

На основании (6) и (7) запишем

$$\rho_L = Z(\theta) \, \frac{\gamma^{1/3}}{\theta_R^2} \, \frac{\theta}{M^{4/3}},\tag{8}$$

где γ — плотность, M — молярная масса проводника, $Z(\Theta)$ — прочие параметры, включая зависящую от температуры плотность состояний d-электронов. Функция $Z(\Theta)$ включает в себя такие параметры, которые оказываются одинаковыми для всех рассматриваемых РЗМ. Значения параметров γ , M и Θ_R для чистых РЗМ содержатся в справочнике [3].

Функцию $Z(\Theta)$ можно рассчитать на основании удельного фононного электросопротивления иттрия. Зная

ее, можно затем на основании табличных данных о плотности, молярной массе и кинетической температуре Дебая лютеция, рассчитать удельное фононное электросопротивление лютеция. Полученное сопротивление, как показывает опыт, в пределах погрешности измерений ρ совпадает с экспериментальным результатом [26]. Это доказывает, что функция $Z(\Theta)$ является универсальной для всех рассматриваемых РЗМ. Таким образом, при известной функции $Z(\Theta)$ может быть рассчитано удельное фононное электросопротивление ρ_L любого рассматриваемого РЗМ.

Примесное электросопротивление оценивается, как обычно, по соотношению сопротивлений при комнатной температуре и при 4.2 К. В конечном итоге на основании (1) рассчитывается магнитный вклад для каждого металла.

В том случае, когда речь идет о сплавах P3M (а это — твердые растворы), вычисления ρ_L проводятся по той же формуле (8). При этом возникает проблема оценки параметров сплавов, таких как γ , M и Θ_R , поскольку в литературе данная информация отсутствует. В первом приближении значения этих параметров могут быть оценены, исходя из концентраций компонентов [28]. Для сплавов Y-Ho (иттрий-гольмий) получим

$$M = (1 - x)M_{\rm Ho} + x M_{\rm Y}, \tag{9}$$

$$\Theta_R = (1 - x)\Theta_{R,\text{Ho}} + x \Theta_{RY}, \qquad (10)$$

$$\gamma = (1 - n)\gamma_{\rm Ho} + n\,\gamma_{\rm Y},\tag{11}$$

$$x = \frac{n}{n + \frac{(1-n)M_{\rm Y}}{M_{\rm Ho}}},$$

где x — концентрация иттрия (атомные доли), n — концентрация иттрия (массовые доли), индексы у γ , M и Θ_R означают металл, чей параметр используется в формулах. Таким образом, формула (8) оказывается пригодной для расчета фононного электрического сопротивления не только чистых РЗМ, но и их сплавов.

Магнитный компонент удельного электрического сопротивления сплавов может быть рассчитан на основании знания ρ_M магнитного металла сплава (в рассматриваемом случае это гольмий). Теория показывает, что в парамагнитной фазе величина этого вклада в удельное сопротивление оказывается пропорциональна концентрации магнитных ионов [9], таким образом, имея в виду систему Y–Ho, запишем

$$\rho_{M,(1-x)} = (1-x)\rho_{M,\text{Ho}}.$$
(12)

В дальнейшем на основании знания ρ_L и ρ_M по формуле (1) может быть рассчитана величина примесного удельного электрического сопротивления сплавов.

3. Обработка экспериментальных результатов

Рассмотрим результаты исследований удельного электросопротивления РЗМ и сплавов Y–Ho, представленные в [3,4,14,15,26,28]. В соответствии с рассмотренной выше третьей схемой разделения вкладов, по формуле (8) были рассчитаны фононные удельные электрические сопротивления ρ_L чистых РЗМ, оценены примесные сопротивления ρ_r , и затем вычислены магнитные компоненты ρ_M . Полученные зависимости, естественно, имели подобный вид, и отличались лишь количественно. На рис. 1 представлены результаты расчетов для Gd, имеющего наибольшее магнитное сопротивление.

Из графиков видно, что по мере нагрева фононный компонент сопротивления ρ_L возрастает и приближается к полному ρ , а магнитный компонент ρ_M стремиться к нулю. Такой ход температурных зависимостей является общим для РЗМ и их сплавов.

На рис. 2 показаны магнитные компоненты удельного электросопротивления для РЗМ, имеющих наибольшие



Рис. 1. Удельное электрическое сопротивление Gd и его компоненты $(1 - \rho, 2 - \rho_L, 3 - \rho_M)$.



Рис. 2. Магнитный компонент сопротивления ρ_M Gd, Tb, Dy и Ho. (1 - Gd, 2 - Tb, 3 - Dy, 4 - Ho).



Рис. 3. Полное удельное электрическое сопротивление РЗМ иттриевой подгруппы (*1* — 300 K, *2* — 1500 K).



Рис. 4. Концентрационные зависимости полного удельного электрического сопротивления сплавов Y-Ho (1 — 300 K, 2 — 1400 K).

значения ρ_M , это Gd, Tb, Dy и Ho. Аналогичные результаты и для сплавов. Таким образом, при температурах выше 1000 К роль магнитного рассеяния в рассматриваемых веществах становится мала.

Данный вывод следует и из рассмотрения зависимостей величин ρ P3M для двух значений температуры: комнатной (300 K) и высокой (1500 K), которые представлены на рис. 3.

При комнатной температуре величина магнитного компонента сопротивления велика. Из-за этого ρ магнитных металлов существенно превышают значения удельных сопротивлений паулевских парамагнетиков Y и Lu. Однако, при высоких температурах ситуация изменяется. Как видно, удельное сопротивление Y становится наибольшим, а по мере приближения к Lu величина ρ снижается. Этот результат находится в согласии с моделью (8), которая описывает фононный вклад. Роль магнитного вклада перестает быть заметной.

Аналогичный вывод можно сделать из анализа концентрационных зависимостей ρ сплавов Y–Ho, показанных на рис. 4. При низких температурах ($\Theta = 300$ K) ρ Ho (x = 0) больше, чем ρ Y. Причина этого — магнитное рассеяние. По мере роста концентрации Y (по мере роста x) ρ остается практически неизменным до x = 60%.

При этом повышение концентрации иттрия и падение доли магнитного сопротивления (12) компенсируются ростом примесного сопротивления, обусловленного увеличением структурного беспорядка в сплаве. Как показывает опыт, между этими влияниями на электросопротивление имеется баланс, и потому ρ практически не изменяется.

При x > 60% падение сопротивления происходит. Это связано как с тем, что снижается магнитное рассеяние, так и с тем что, снижается примесное рассеяние. Максимум примесного рассеяния, как показывает анализ [28], приходится на середину концентрационной зависимости. Таким образом, при температуре 300 К роль магнитного рассеяния заметна. При температуре 1400 К ситуация иная. Сопротивление Но меньше, чем сопротивление Y. При движении по концентрационной зависимости наблюдается только эффект от структурного беспорядка (максимум сопротивления вблизи x = 50%, правило Нордгейма [11]). Влияние магнитного рассеяния не прослеживается.

Наблюдаемое экспериментально пересечение политерм ρ чистых P3M [3,14,15] и их сплавов [4,28] как раз и вызвано тем, что по мере роста температуры снижается величина ρ_M практически до нуля, и основным рассеивающим фактором становятся колебания решетки.

Рассмотренные особенности концентрационных и температурных зависимостей удельных электросопротивлений РЗМ и их сплавов не находят объяснения в том случае, если принять, что ρ_M при высоких температурах является постоянной величиной (как это следует из первой схемы разделения вкладов).

Таким образом, имеющийся экспериментальный материал позволяет утверждать, что магнитное сопротивление в парамагнитных РЗМ и их сплавах дает заметный вклад в ρ только при средних температурах. При высоких температурах этого вклада практически нет.

Обсуждение полученных результатов

Проблема, возникшая из рассмотрения температурной зависимости ρ_M P3M и их сплавов, заключается в том, что на сегодняшний день отсутствует физическая модель, объясняющая снижение магнитного электросопротивления парамагнитных металлов при нагреве. Следует отметить, что и при низких температурах, когда магнитные структуры P3M находятся в упорядоченном состоянии, модели не дают достаточно точного описания температурной зависимости $\rho_M(\Theta)$.

Для иллюстрации этого лучше всего провести анализ свойств гадолиния, поскольку его ρ_M наибольшее, и потому относительная погрешность оценки минимальна. Процесс выделения ρ_M проведем по третьей схеме, вычисляя ρ_L по формуле (8). Для низкотемпературной области воспользуемся литературными данными для ρ



Рис. 5. Магнитный компонент электросопротивления ρ_M Gd в ферромагнитной и парамагнитной областях температур.

из справочника [3]. Соответствующий результат показан на рис. 5.

Видно, что ρ_M это дополнительный вклад в ρ , обеспечивающий превышение величины сопротивления над фононным и примесным вкладами. Максимальная величина ρ_M соответствует температуре Кюри Θ_C [3]. Закономерности, определяющие изменение сопротивления при нагреве, неодинаковы для ферромагнитной и парамагнитной областей. Неодинаковы, естественно, и физические причины, ответственные за рост и снижение ρ_M . Аппроксимация полученных результатов дает следующие соотношения:

для
$$\Theta < \Theta_{\rm C}$$
: $\rho_M = 14 \cdot 10^{-11} \cdot \Theta^{3/2}, \ \Omega \cdot {\rm m},$ (13)

для $\Theta > \Theta_{\rm C}$: $\rho_M = 145 \cdot 10^{-8} \exp(-2.2 \cdot 10^{-3} \Theta), \ \Omega \cdot {\rm m}.$ (14)

Опыт показывает, что в ферромагнитной фазе рост ρ_M происходит по степенному закону (13). Такой ход политермы, в целом, соответствует имеющимся теоретическим представлениям о роли магнитного рассеяния [6,16]. Однако, показатель степени 3/2 установлен только для "экзотического случая": рассеяния электронов на двухмерных спиновых волнах вблизи границ доменов [16]. Достаточно общего решения этой задачи, позволяющего оценить ρ_M ферромагнитного металла в рамках модели многополосной проводимости, до сих пор нет.

В области высоких температур $\Theta > \Theta_{\rm C}$ опыт показывает, что величина магнитного сопротивления уменьшается практически до нуля. Убывание происходит по экспоненциальному закону (14). На сегодняшний день нет моделей, опирающихся на "первые принципы", и позволяющие понять данный факт. Как уже отмечалось выше, теоретические расчеты дают иные результаты: ρ_M либо остается неизменным, либо даже возрастает при нагреве в парамагнитной области. Парамагнитная фаза рассматривается как область наивысшего магнитного беспорядка в системе, благодаря чему в большинстве моделей ρ_M достигает максимума при Θ_C и далее при повышении температуры остается неизменным. Таким образом, имеющиеся модели противоречат опыту.

Вместе с тем, постоянство ρ_M при высоких температурах является следствием приближений, сделанных при проведении вычислений. В частности, рассмотрим классический результат оценки ρ_M [6]. В парамагнитном состоянии величина сопротивления определяется функцией де Жена G:

$$G = (g_J - 1)^2 J(J + 1),$$
(15)

$$\rho_M = \frac{3\pi N m_e^*}{8\hbar e^2 \eta V} A_0^2 G, \qquad (16)$$

где g_J — фактор (множитель) Ланде [6], J — полное квантовое число иона РЗМ [17], A₀ — параметр обмена (обменный интеграл), N — число ионов в объеме V, m_e^* — эффективная масса электрона проводимости, η химический потенциал (уровень Ферми) электронов проводимости, е — заряд электрона. В выражении (16) все представленные величины являются константами, в том числе и обменный интеграл А₀. Реально, однако, этот параметр косвенного обмена зависит от взаимного расстояния между ионами металла. Как известно, спиновая плотность электронов проводимости в зависимости от расстояния при косвенном обмене является осциллирующей функцией [6,17,29] (подобно тому, как осциллирует плотность электрического заряда экранированного потенциала примеси [30]). Естественно, что и величина обменного интеграла должна оказаться зависящей от расстояния между ионами, и следовательно, от температуры. Это обстоятельство должно привести к температурному изменению ρ_M . К сожалению, последовательные расчеты, учитывающие непостоянство обменного интеграла, не произведены. Не рассмотрены и процессы многополосного рассеяния при оценке ρ_M .

Хотелось бы отметить, что при оценке ρ_M не только P3M, но и других переходных металлов и сплавов, также наблюдаются противоречия между экспериментом и модельными представлениями [31].

Таким образом, в настоящее время задача адекватного описания магнитного компонента рассеяния электронов в переходных, в том числе редкоземельных металлах, в широком диапазоне температур не решена. Проблема эта принадлежит к разряду фундаментальных, ее решение необходимо для выяснения физики магнетизма и физики явлений переноса в переходных металлах при высоких температурах.

5. Выводы

Экспериментальное исследование удельного электрического сопротивления РЗМ и их сплавов позволило установить, что магнитный компонент электрического сопротивления в парамагнитной фазе в твердом состоянии снижается по мере нагрева.

Методы теоретического описания магнитного рассеяния, разработанные к настоящему времени, противоречат данному результату.

Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 11-08-00275 и 14-08-00228.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- H.Л. Глинка. Общая химия / Под ред. А.И. Ермакова. Интеграл-Пресс, М. (2000). 728 с.
- [2] М.Ю. Черноскутов, А.Д. Ивлиев, В.В. Мешков, А.О. Самойлов, А.С. Соснин. Измерительная техника 5, 60 (2018).
- [3] В.Е. Зиновьев. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Металлургия, М. (1989). 384 с.
- [4] М.Ю. Черноскутов, А.Д. Ивлиев, В.В. Мешков. В сб.: XV Рос. конф. (с междунар.участием) по теплофизическим свойствам веществ (РКТС-15) и научная школа для молодых ученых. Тезисы докл. (Москва, 15–17 октября 2018 г.) Янус-К, М. (2018). С. 90.
- [5] Handbook on the Physics and Chemistry of the Rare Earths / Ed. K.A. Gschneider Jr, L. Eyring. North-Holland, Amsterdam (1978). 1: Metals.
- [6] К. Тейлор, М. Дарби. Физика редкоземельных соединений. Мир, М. (1974). 375 с.; [К.N.R. Taylor, M.I. Darby. Physics of Rare Earth Solids. Chapman and Hall Ltd., London. (1972)].
- [7] С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. МГУ, М. (1989). 248 с.
- [8] Y. Wang, M.Y. Chou. Phys. Rev. B 44, 10339 (1991).
- [9] R.I.R. Blyth, S.D. Barrett, S.S. Dhesi, R. Cosso, N. Heritage, A.M. Begley, R.G. Jordan. Phys. Rev. B 44, 5423 (1991).
- [10] В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов, В.Г. Алешин. Докл. АН СССР 228, 837 (1976).
- [11] Дж. Займан. Электроны и фононы. Изд-во ИЛ, М. (1962).
 488 с.; [J.M. Ziman. Electrons and Phonons. Oxford at the Clarendon Press (1960). 397 p.].
- [12] Ф. Блатт. Физика электронной проводимости в твердых телах. Мир, М. (1971). 470 с.; [F.J. Blatt. Physics of Electronic Conduction in Solids. McGraw-Hill Book Company (1968)].
- [13] Н.Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Мир, М. (1979). 1. 399 с.; 2. 422 с.); [N.W. Ashcroft, N.D. Mermin. Solid State Physics. Holt, Rinehart and Winston, N.Y. (1976)].
- [14] А.Д. Ивлиев. Высокотемпературные теплофизические свойства твердых редкоземельных металлов. Дис. докт. физ. мат. наук. Уральский горный институт им. В.В. Вахрушева, Екатеринбург (1991). 455 с.
- [15] А.Н. Поздеев, А.Д. Ивлиев, А.А. Куриченко, Е.З. Ривман, Н.И. Морева. ФММ 9, 85 (1990).
- [16] С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с.

- [17] Р. Уайт. Квантовая теория магнетизма. Мир, М. (1985). 303 с.) ; [R.M. White. Quantum Theory of Magnetism. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg N.Y. (1983)].
- [18] В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в *d-* и *f*-металлах и их соединениях. УрО РАН, Екатеринбург. (2004). 472 с.
- [19] A. Watabe, T. Kasuya. J. Phys. Soc. Jpn 26, 64 (1969).
- [20] R. Jullien, M.T. Beal-Monod, B. Coqblin. Phys. Rev. B 9, 1441 (1974).
- [21] В.И. Гребенников, Ю.И. Прокопьев. ФММ 60, 213 (1985).
- [22] В.Т. Швец. ФТТ 33, 261 (1991).
- [23] Ю.Ю. Циовкин, Л.Ю. Вишнеков, А.Н. Волошинский. ФММ 8, 76 (1991).
- [24] H.-J. Güntherodt, E. Hauser, H.U. Künzi. Proc. 3rd Int. Conf. on Liquid Metals. Bristol, 1976; Inst. Phys. Conf. Ser. N 30, Bristol and London. (1977) P. 324.
- [25] A.T. Burkov, M. Vedernikov, E. Grats. Physica B 176, 263 (1992).
- [26] А.Д. Ивлиев. ФММ 75, 9 (1993).
- [27] N.F. Mott. Proc. Phys. Soc. 47, 571 (1935).
- [28] А.Д. Ивлиев, М.Ю. Черноскутов, В.В. Мешков, А.А. Куриченко, Н.И. Морева. В кн.: V Междунар. научнотехн. конф. "Современные методы и средства исследования теплофизических свойств веществ". 23–24 мая 2019 г. Сб. трудов. ИТМО, СПб (2019). С. 8. eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42140558
- [29] К.П. Белов. Редкоземельные магнетики и их применение. Наука, М. (1980). 239 с.
- [30] Дж. Займан. Принципы теории твердого тела. Мир, М. (1974). 472 с.); [J.M. Ziman. Principles of the Theory of Solids. Cambridge at the University Press. (1972)].
- [31] А.Д. Ивлиев, Ю.В. Глаголева. ФТТ 53, 1106 (2011).

Редактор К.В. Емцев